

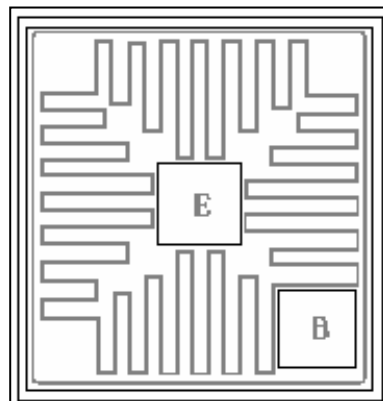


965 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
 芯片代码：C089BJ-00
 芯片厚度：240 ± 20μm
 管芯尺寸：890 × 890μm²
 焊位尺寸：B 极 150×150μm²；E 极 153×153μm²
 电极金属：铝
 背面金属：金
 典型封装：2SD965，HD965

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

T_{stg}——贮存温度..... -55~150
 T_j——结温..... 150
 P_C——集电极耗散功率..... 0.75W
 V_{CB0}——集电极—基极电压..... 40V
 V_{CEO}——集电极—发射极电压..... 20V
 V_{EBO}——发射极—基极电压..... 7V
 I_C——集电极电流..... 3A

电参数 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I _{CB0}	集电极—基极截止电流			50	nA	V _{CB} =30V, I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			50	nA	V _{EB} =5V, I _C =0
V _{CEO}	集电极-发射极电压	20			V	I _C =10mA, I _B =0
V _{EBO}	发射极-基极电压	6			V	I _E =1mA, I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	180		800		V _{CE} =2V, I _C =0.5A
	直流电流增益	100				V _{CE} =2V, I _C =1A
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			2.0	V	I _C =3A, I _B =0.1A
f _T	特征频率		150		MHz	V _{CB} =6V, I _E =50mA
C _{ob}	共基极输出电容			50	pF	V _{CB} =20V, I _E =0, f=1MHz